

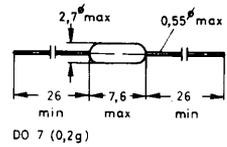


BYX 60/50
bis
BYX 60/800

Si-Gleichrichter, $I_N = 400 \text{ mA}$

vorläufige Daten

Ausführung Diffundierte Si-Gleichrichterzellen im Glas-Gehäuse DO 7. Typenkennzeichnung durch weissen Farbring oder aufgedruckten Klartext auf der Katodenseite.



Anwendung Für professionelle Anwendung.

Grenzwerte bei $T_U = 25^\circ\text{C}$

		BYX 60/50	BYX 60/100	BYX 60/200	BYX 60/400	BYX 60/600	BYX 60/800	
Gleichsperrspannung	U_R	50	100	200	400	600	800	V
periodische Spitzensperrspannung	U_{RR}	50	100	200	400	600	800	V
Nennstrom	I_N	400						mA
periodischer Spitzenstrom	I_{FR}	1						A
Stoss-Strom $t < 10 \text{ ms}$	I_{FS}	2,5						A
Lager-temperatur	T_S	-50... 150						$^\circ\text{C}$
Betriebs-temperatur	T_U	-50... 125						$^\circ\text{C}$
Wärme-widerstand								$^\circ\text{C}$
Sperrschicht/ Luft	R_{thU}	250						

BYX 60/50
 bis
 BYX 60/800

Si-Gleichrichter, $I_N = 400 \text{ mA}$

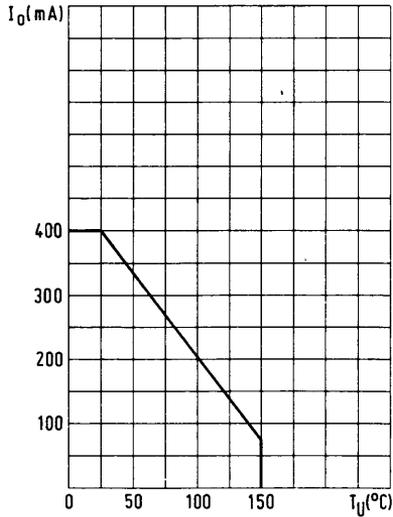
vorläufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei $T_U = 25^\circ\text{C}$

Sperrstrom bei U_{RR} bei $T_U = 100^\circ\text{C}$		I_R	<1	μA
			<50	
Durchlass- Spannung	$I_F = I_N$	U_F	<1,2	V
Sperrschicht- kapazität $f = 1 \text{ MHz}$	$U_R = 12 \text{ V}$	C_j	<12	pF

Zulässiger Richtstrom

$I_0 = f(T_U)$





1 N 3900
 1 N 3901
 1 N 3903
 BYX 63/600

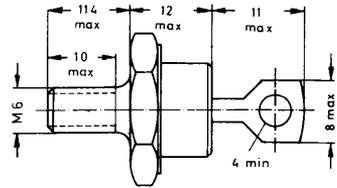
Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 20 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 200 \text{ ns}$

vorläufige Daten

Ausführung Diffundierte Si-Gleichrichterzellen im Metallgehäuse DO 5

- normale Ausführung: Katode am Gehäuse
- inverse Ausführung: Anode am Gehäuse (Kennzeichnung durch Buchstaben R, z. B. 1 N 3900 R)

Typenkennzeichnung in Klartext.



DO 5 (16,5g)

Anwendung Professionelle Elektronik

Grenzwerte bei $T_G = 25^\circ\text{C}$

		1 N 3900	1 N 3901	1 N 3903	BYX 63/600	
Scheitelsperrspannung	U_{RW}	100	200	400	600	V
periodische Spitzensperrspannung	U_{RR}	100	200	400	600	V
mittl. Richtstrom bei $T_G < 100^\circ\text{C}$	I_0	20				A
Stoss-Strom $t < 10 \text{ ms}$	I_{FS}	225				A
Lagertemperatur	T_S	-65...175				$^\circ\text{C}$
Gehäusetemperatur (1)	T_G	-65...150				$^\circ\text{C}$
maximales Anzugsmoment	M	0,2				kpm

(1) Messpunkt: Mitte-Schlüsselfläche des Sechskantgehäuses.

1 N 3900
 1 N 3901
 1 N 3903

BYX 63/600

Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 20 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 200 \text{ ns}$

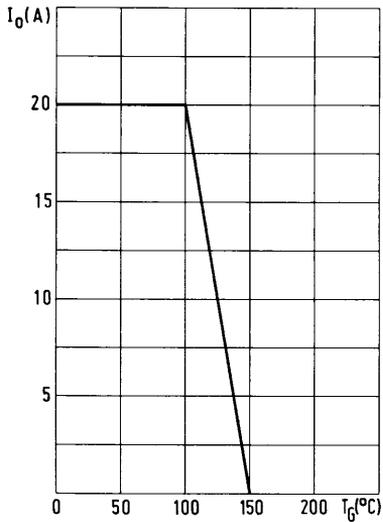
vorläufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei $T_G = 25^\circ\text{C}$

Durchlass-Spannung	$I_F = 20 \text{ A}$	U_F	<1,4	V
bei $T_G = 100^\circ\text{C}$	I_0 u. U_{RW}		<1,5	V
Sperrstrom	$U_R = U_{RW}$	I_R	50	μA
bei $T_G = 100^\circ\text{C}$	$U_R = U_{RW}$ I_0 u. U_{RW}		<6 <10	mA
Sperrverzögerungszeit	$I_F = 1 \text{ A}$ $I_{RS} < 3 \text{ A}$ $U_R = 30 \text{ V}$	t_{rr}	<200	ns

Maximal zulässiger
 Richtstrom

$$I_0 = f(T_G)$$





Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 20 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 200 \text{ ns}$

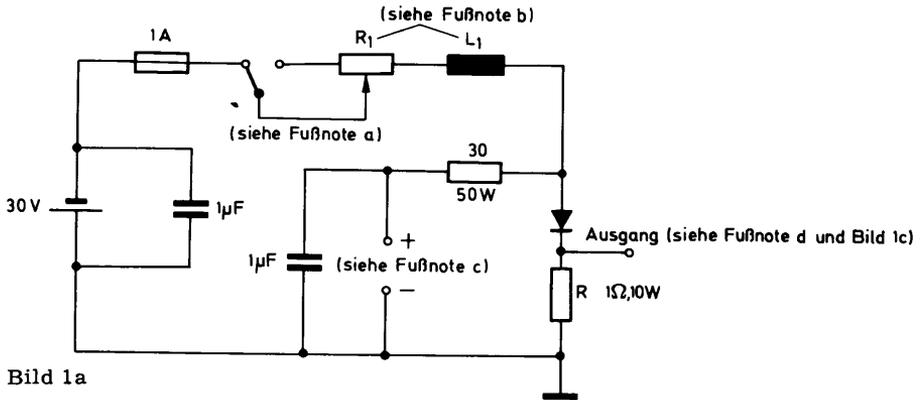


Bild 1a

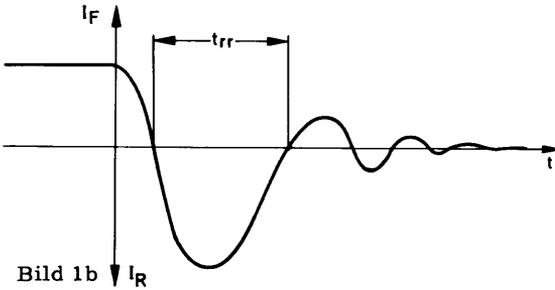


Bild 1b

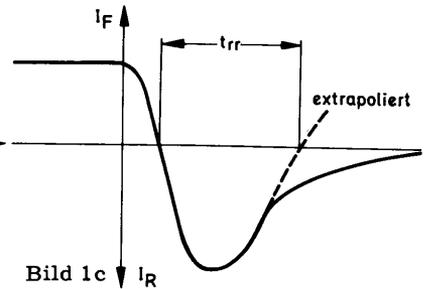


Bild 1c

Meßbedingungen nach JEDEC für die Sperrverzögerungszeit t_{rr}

Fussnoten

- a) Quecksilberrelais: Schaltfrequenz 50 Hz
Schaltstellung 1: Vorwärtsstrom (Zeitdauer 9,25 ms)
Schaltstellung 2: Sperrstrom (Zeitdauer 750 μ s)
- b) R_1 Regelwiderstand: 30 Ω /25 W
Einstellung: 1,2 Ω
- L_1 Induktivität: 30 μ H
- c) Spannungs-konstantquelle: Innenwiderstand <0,5 Ω
 $I_F = 1 \text{ A}$ wird durch Veränderung der Versorgungsspannung eingestellt
- d) Oszillograph: 0... 30 MHz
Eingangsimpedanz: 1 Ω /8 pF
- Tastkopf: Teilverhältnis: 1:10
 $L = 0,5 \mu$ H
 $C = 3... 12 \text{ pF}$
 $R = 9 \text{ M}\Omega$



1 N 3910
 1 N 3911
 1 N 3913
 BYX 64/600

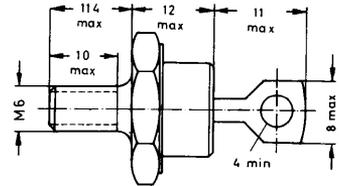
Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 30 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 200 \text{ ns}$

vorläufige Daten

Ausführung Diffundierte Si-Gleichrichterzellen im Metallgehäuse DO 5

- normale Ausführung: Katode am Gehäuse
- inverse Ausführung: Anode am Gehäuse (Kennzeichnung durch Buchstaben R, z. B. 1 N 3910 R)

Typenkennzeichnung in Klartext.



DO 5 (16,5g)

Anwendung Professionelle Elektronik

Grenzwerte bei $T_G = 25^\circ\text{C}$

	1 N 3910	1 N 3911	1 N 3913	BYX 64/600	
Scheitelsperrspannung U_{RW}	100	200	400	600	V
periodische Spitzensperrspannung U_{RR}	100	200	400	600	V
mittl. Richtstrom I_0 bei $T_G \leq 100^\circ\text{C}$	30				A
Stoss-Strom I_{FS} $t < 10 \text{ ms}$	300				A
Lagertemperatur T_S	-65... 175				$^\circ\text{C}$
Gehäuse temperatur (1) T_G	-65... 150				$^\circ\text{C}$
maximales Anzugsmoment M	0,2				kpm

(1) Messpunkt: Mitte-Schlüsselfläche des Sechskantgehäuses.

1 N 3910

1 N 3911

1 N 3913

BYX 64/600

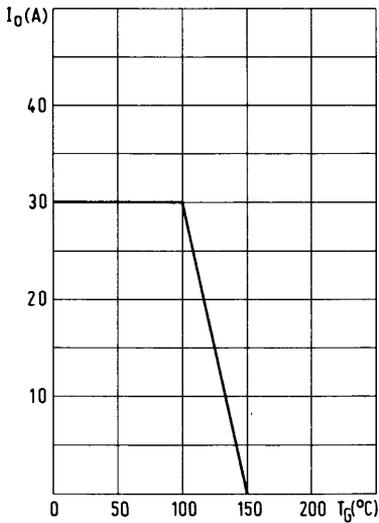
Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 30 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 200 \text{ ns}$

vorläufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei $T_G = 25^\circ\text{C}$

Durchlass-Spannung	$I_F = 30 \text{ A}$	U_F	<1,4	V
bei $T_G = 100^\circ\text{C}$	I_0 u. U_{RW}		<1,5	
Sperrstrom	$U_R = U_{RW}$	I_R	<50	μA
bei $T_G = 100^\circ\text{C}$	$U_R = U_{RW}$ I_0 u. U_{RW}		<6 <10	mA
Sperrverzögerungszeit	$I_F = 1 \text{ mA}$ $I_{RS} < 3 \text{ A}$ $U_R = 30 \text{ V}$	t_{rr}	<200	ns

Maximal zulässiger
Richtstrom
 $I_0 = f(T_G)$





Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 30 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 200 \text{ ns}$

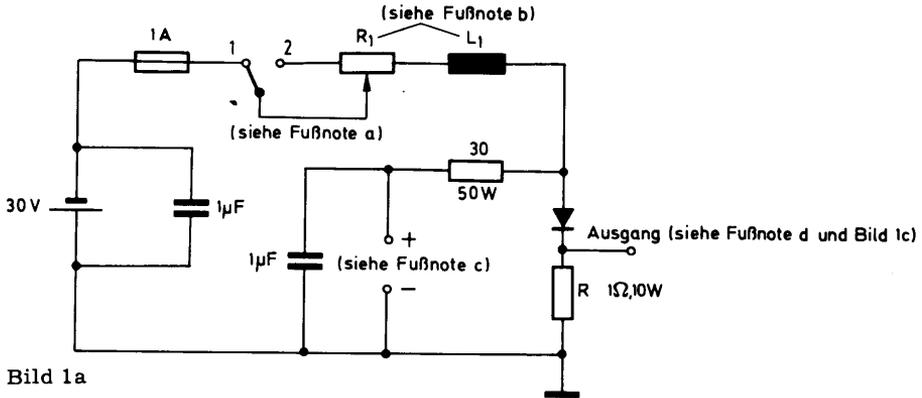


Bild 1a

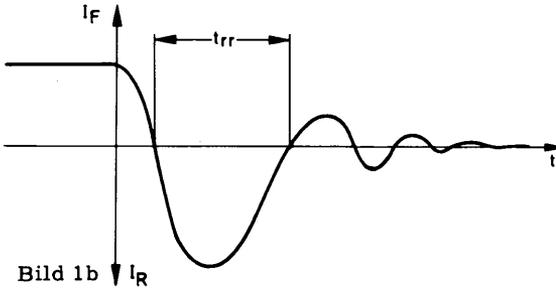


Bild 1b

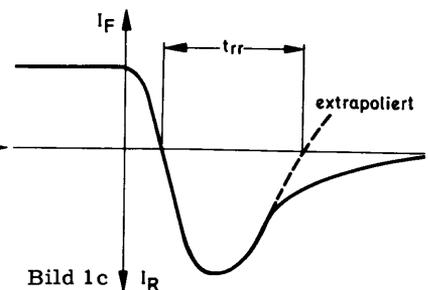


Bild 1c

Meßbedingungen nach JEDEC für die Sperrverzögerungszeit t_{rr}

Fussnoten

- a) Quecksilberrelais: Schaltfrequenz 50 Hz
 Schaltstellung 1: Vorwärtsstrom (Zeitdauer 9,25 ms)
 Schaltstellung 2: Sperrstrom (Zeitdauer 750 µs)
- b) R_1 Regelwiderstand: 30 Ω/25 W
 Einstellung: 1,2 Ω
- L_1 Induktivität: 30 µH
- c) Spannungs-konstantquelle: Innenwiderstand < 0,5 Ω
 $I_F = 1 \text{ A}$ wird durch Veränderung der Versorgungsspannung eingestellt.
- d) Oszillograph: 0... 30 MHz
 Eingangsimpedanz: 1 Ω/8pF
- Tastkopf: Teilverhältnis: 1:10
 $L = 0,5 \text{ µH}$
 $C = 3... 12 \text{ pF}$
 $R = 9 \text{ MΩ}$



BYX 65/100
 BYX 65/200
 BYX 65/400

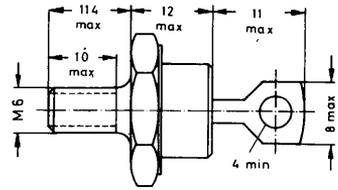
Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 30 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 100 \text{ ns}$

vorläufige Daten

Ausführung Diffundierte Si-Gleichrichterzellen im Metallgehäuse DO 5

- normale Ausführung: Katode am Gehäuse
- inverse Ausführung: Anode am Gehäuse (Kennzeichnung durch Buchstaben R, z. B. BYX 65/100 R)

Typenkennzeichnung in Klartext.



DO 5 (16,5g)

Anwendung Professionelle Elektronik

Grenzwerte bei $T_G = 25^\circ\text{C}$

		BYX 65/100	BYX 65/200	BYX 65/400	
Scheitelsperrspannung	U_{RW}	100	200	400	V
periodische Spitzensperrspannung	U_{RR}	100	200	400	V
mittl. Richtstrom bei $T_G < 100^\circ\text{C}$	I_0	30			A
Stoss-Strom $t < 10 \text{ ms}$	I_{FS}	300			A
Lagertemperatur	T_S	-65...175			$^\circ\text{C}$
Gehäusetemperatur (1)	T_G	-65...150			$^\circ\text{C}$
maximales Anzugsmoment	M	0,2			kpm

(1) Messpunkt: Mitte-Schlüsselfläche des Sechskantgehäuses.

BYX 65/100
BYX 65/200
BYX 65/400

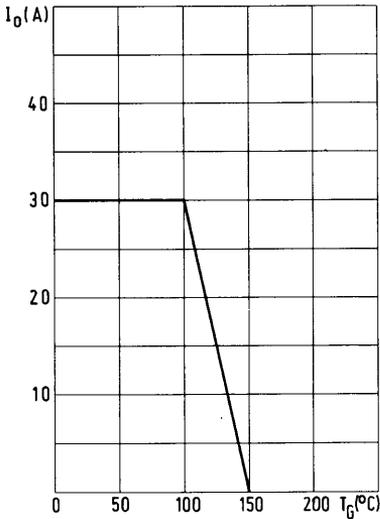
Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 30 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 100 \text{ ns}$

vorläufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei $T_G = 25^\circ\text{C}$

Durchlass-Spannung	$I_F = 30 \text{ A}$	U_F	$<1,5$	V
Sperrstrom bei $T_G = 100^\circ\text{C}$	$U_R = U_{RW}$	I_R	<80	μA
			<10	mA
Sperrverzögerungszeit	$I_F = 1 \text{ A}$ $U_R = 30 \text{ V}$	t_{rr}	<100	ns

Maximal zulässiger
Richtstrom
 $I_0 = f(T_G)$





BYX 65/100
 BYX 65/200
 BYX 65/400

Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 30 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 100 \text{ ns}$

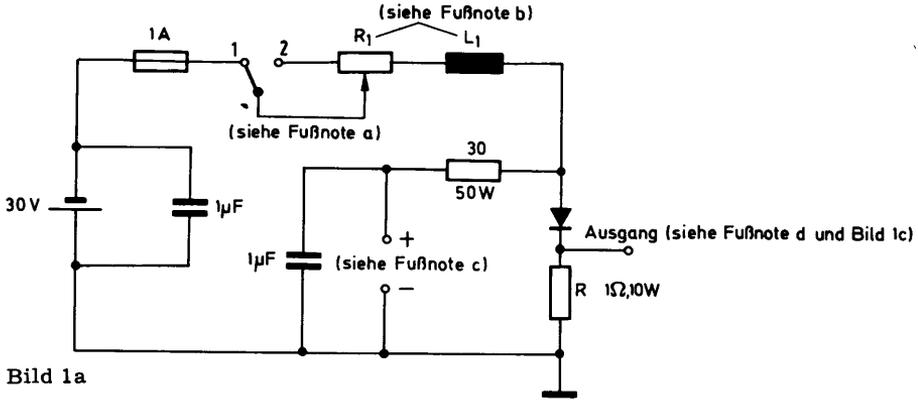


Bild 1a

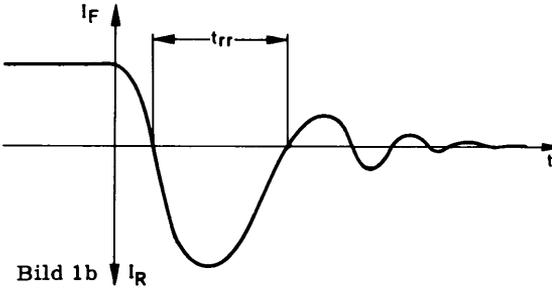


Bild 1b

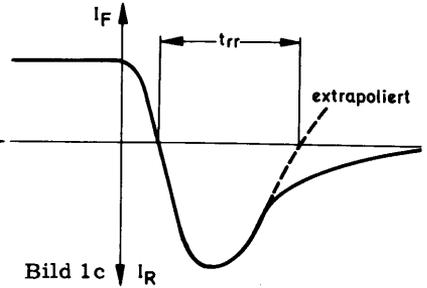


Bild 1c

Meßbedingungen nach JEDEC für die Sperrverzögerungszeit t_{rr}

Fussnoten

- a) Quecksilberrelais: Schaltfrequenz 50 Hz
 Schaltstellung 1: Vorwärtsstrom (Zeitdauer 9,25 ms)
 Schaltstellung 2: Sperrstrom (Zeitdauer 750 μs)
- b) R_1 Regelwiderstand: 30 Ω /25 W
 Einstellung: 1,2 Ω
- L_1 Induktivität: 30 μH
- c) Spannungskonstantquelle: Innenwiderstand < 0,5 Ω
 $I_F = 1 \text{ A}$ wird durch Veränderung der Versorgungsspannung eingestellt
- d) Oszillograph: 0... 30 MHz
 Eingangsimpedanz: 1 Ω /8 pF
- Tastkopf: Teilverhältnis: 1:10
 $L = 0,5 \mu\text{H}$
 $C = 3... 12 \text{ pF}$
 $R = 9 \text{ M}\Omega$



BYX 66/400
 BYX 66/600
 BYX 66/800
 BYX 66/1000

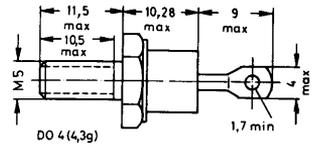
Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 12 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 500 \text{ ns}$

vorläufige Daten

Ausführung Diffundierte Si-Gleichrichterzellen im Metallgehäuse DO 4

- normale Ausführung: Katode am Gehäuse
- inverse Ausführung: Anode am Gehäuse (Kennzeichnung durch Buchstaben R, z. B. BYX 66/400 R)

Typenkennzeichnung in Klartext.



Anwendung Professionelle Elektronik.

Grenzwerte bei $T_G = 25^\circ\text{C}$

		BYX 66/400	BYX 66/600	BYX 66/800	BYX 66/1000	
Scheitelsperrspannung	U_{RW}	400	600	800	1000	V
periodische Spitzensperrspannung	U_{RR}	400	600	800	1000	V
mittl. Richtstrom bei $T_G \leq 100^\circ\text{C}$	I_0	12				A
Stoss-Strom $t < 10 \text{ ms}$	I_{FS}	150				A
Lagertemperatur	T_S	-65... 175				$^\circ\text{C}$
Gehäusetemperatur (1)	T_G	-65... 150				$^\circ\text{C}$
maximales Anzugsmoment	M	0,2				kpm

(1) Meßpunkt: Mitte-Schlüsselfläche des Sechskantgehäuses.

BYX 66/400
 BYX 66/600
 BYX 66/800
 BYX 66/1000

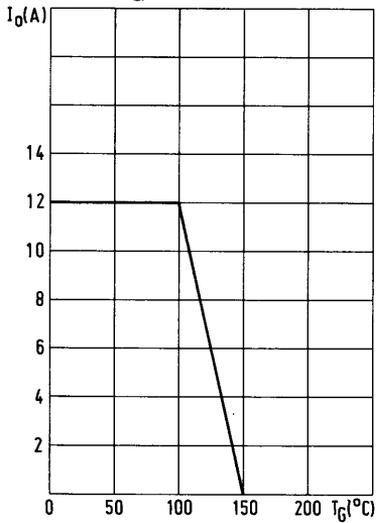
Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 12 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 500 \text{ ns}$

vorläufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei $T_G = 25^\circ\text{C}$

Durchlass-Spannung	$I_F = 12 \text{ A}$	U_F	<1,5	V
Sperrstrom bei $T_G = 100^\circ\text{C}$	$U_R = U_{RW}$	I_R	<25	μA
	$U_R = U_{RW}$		<3	mA
Sperrverzögerungszeit	$I_F = 1 \text{ mA}$ $U_R = 30 \text{ V}$	t_{rr}	<500	ns

Maximal zulässiger
 Richtstrom
 $I_0 = f(T_G)$





BYX 66/400
 BYX 66/600
 BYX 66/800
 BYX 66/1000

Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 12 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 500 \text{ ns}$

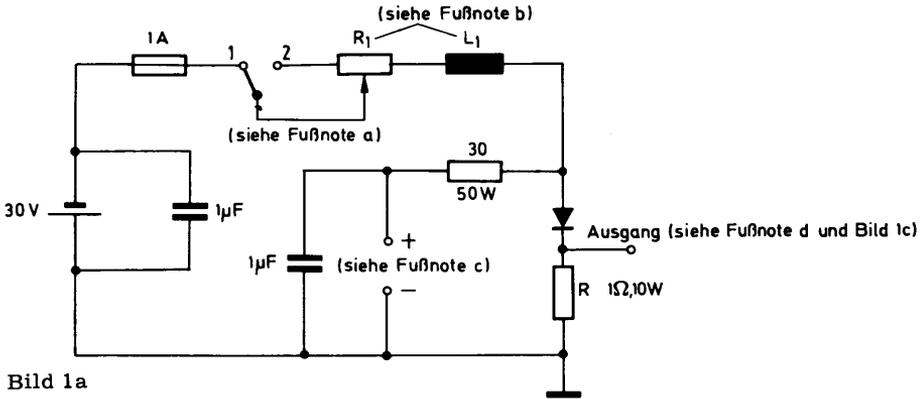


Bild 1a

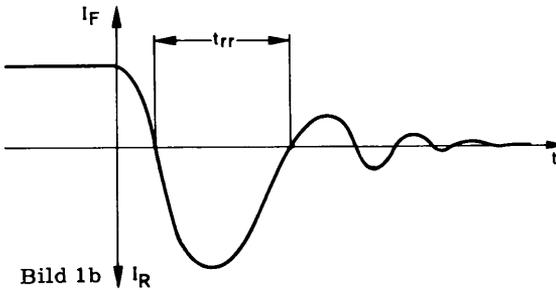


Bild 1b

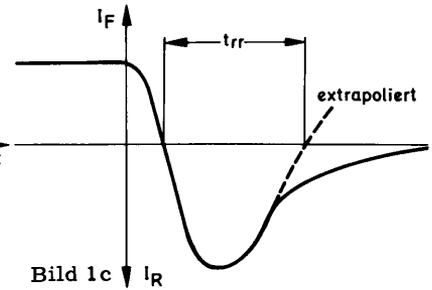


Bild 1c

Meßbedingungen nach JEDEC für die Sperrverzögerungszeit t_{rr}

Fussnoten

- a) Quecksilberrelais: Schaltfrequenz 50 Hz
 Schaltstellung 1: Vorwärtsstrom (Zeitdauer 9,25 ms)
 Schaltstellung 2: Sperrstrom (Zeitdauer 750 μ s)
- b) R_1 Regelwiderstand: 30 Ω /25 W
 Einstellung: 1,2 Ω
 L_1 Induktivität: 30 μ H
- c) Spannungsconstantquelle: Innenwiderstand <0,5 Ω
 $I_F = 1 \text{ A}$ wird durch Veränderung der Versorgungsspannung eingestellt
- d) Oszillograph: 0... 30 MHz
 Eingangsimpedanz: 1 Ω /8pF
 Tastkopf: Teilverhältnis:1:10
 $L = 0,5 \mu$ H
 $C = 3... 12 \text{ pF}$
 $R = 9 \text{ M}\Omega$



BYX 67/400
 BYX 67/600
 BYX 67/800
 BYX 67/1000

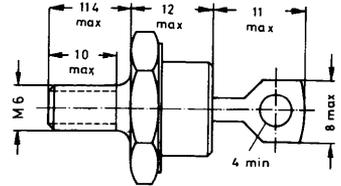
Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 30 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 500 \text{ ns}$

vorläufige Daten

Ausführung Diffundierte Si-Gleichrichterzellen im Metallgehäuse DO 5

- normale Ausführung: Katode am Gehäuse
- inverse Ausführung: Anode am Gehäuse (Kennzeichnung durch Buchstaben R, z. B. BYX 67/600 R)

Typenkennzeichnung in Klartext.



DO 5 (16,5g)

Anwendung Professionelle Elektronik.

Grenzwerte bei $T_G = 25^\circ\text{C}$

		BYX 67/400	BYX 67/600	BYX 67/800	BYX 67/1000	
Scheitelsperrspannung	U_{RW}	400	600	800	1000	V
periodische Spitzensperrspannung	U_{RR}	400	600	800	1000	V
mittl. Richtstrom bei $T_G \leq 100^\circ\text{C}$	I_0	30				A
Stoss-Strom $t < 10 \text{ ms}$	I_{FS}	300				A
Lagertemperatur	T_S	-65... 175				$^\circ\text{C}$
Gehäusetemperatur (1)	T_G	-65... 150				$^\circ\text{C}$
maximales Anzugsmoment	M	0,2				kpm

(1) Meßpunkt: Mitte-Schlüsselfläche des Sechskantgehäuses.

BYX 67/400
 BYX 67/600
 BYX 67/800
 BYX 67/1000

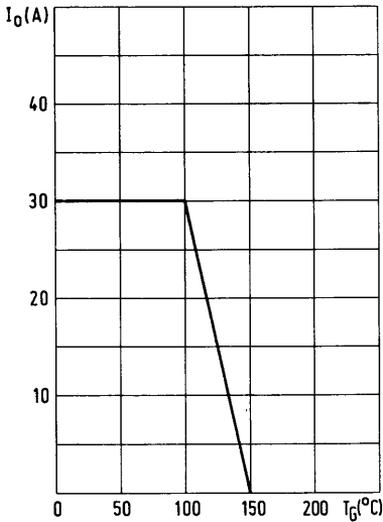
Schnelle Si-Gleichrichter, $I_0 = 30 \text{ A}$, $t_{rr} \leq 500 \text{ ns}$

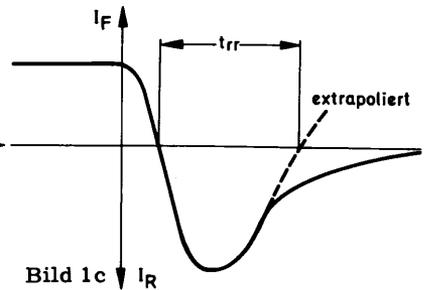
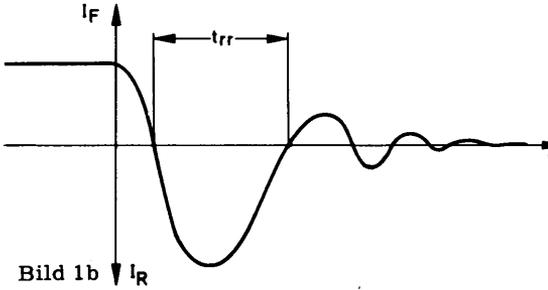
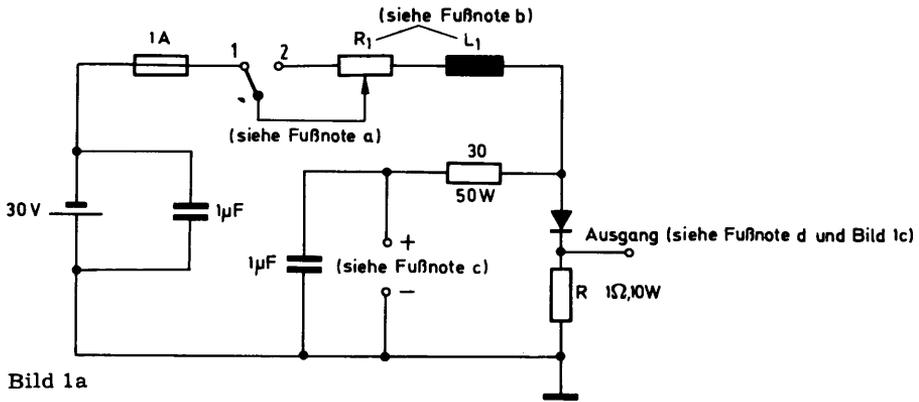
vorläufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei $T_G = 25^\circ\text{C}$

Durchlass-Spannung	$I_F = 30 \text{ A}$	U_F	<1,5	V
Sperrstrom bei $T_G = 100^\circ\text{C}$	$U_R = U_{RW}$	I_R	<80	μA
	$\bar{U}_R = \bar{U}_{RW}$		<10	mA
Sperrverzögerungszeit	$I_F = 1 \text{ mA}$ $U_R = 30 \text{ V}$	t_{rr}	<500	ns

Maximal zulässiger
 Richtstrom
 $I_0 = f(T_G)$



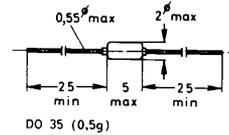


Meßbedingungen nach JEDEC für die Sperrverzögerungszeit t_{rr}

Fussnoten

- | | |
|------------------------------|--|
| a) Quecksilberrelais: | Schaltfrequenz 50 Hz
Schaltstellung 1: Vorwärtsstrom (Zeitdauer 9,25 ms)
Schaltstellung 2: Sperrstrom (Zeitdauer 750 μs) |
| b) R_1 | Regelwiderstand: 30 Ω /25 W
Einstellung: 1,2 Ω |
| L_1 | Induktivität: 30 μH |
| c) Spannungs-konstantquelle: | Innenwiderstand < 0,5 Ω
$I_F = 1 \text{ A}$ wird durch Veränderung der Versorgungsspannung eingestellt |
| d) Oszillograph: | 0... 30 MHz
Eingangsimpedanz: 1 Ω /8 pF |
| Tastkopf: | Teilverhältnis: 1: 10
$L = 0,5 \mu\text{H}$
$C = 3... 12 \text{ pF}$
$R = 9 \text{ M}\Omega$ |

Ausführung Silizium-Diode in Epitaxial-Planar-Technik im Glasgehäuse DO 35. Typenkennzeichnung durch Farbringe oder durch aufgedruckten Klartext und schwarzen Farbring auf der Katodenseite.



Anwendung Als Stabilisatordiode.

Grenzwerte bei $T_U = 25^\circ\text{C}$

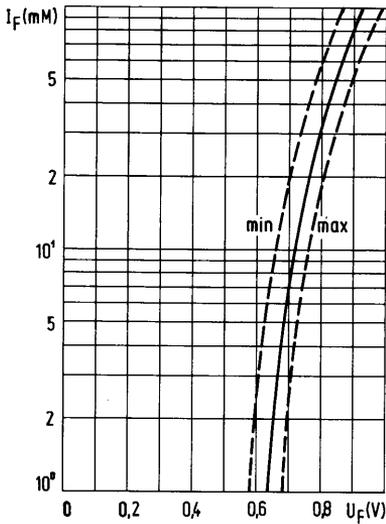
Sperrspannung	U_R	2	V
Durchlass-Strom	I_F	150	mA
Durchlass-Spitzenstrom	I_{FS}	250	mA
Verlustleistung	P_{tot}	250	mW
Sperrschichttemperatur	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	T_S	-65...200	$^\circ\text{C}$

Allgemeine Kennwerte bei $T_U = 25^\circ\text{C}$

Durchlass-Spannung	$I_F = 1 \text{ mA}$ $I_F = 2 \text{ mA}$ $I_F = 5 \text{ mA}$ $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_F = 100 \text{ mA}$	U_F	0,580...0,680 0,605...0,705 0,650...0,750 0,675...0,775 0,710...0,810 <1,000	V
Sperrstrom	$U_R = 2 \text{ V}$	I_R	<1	μA
Sperrschichtkapazität $f = 1 \text{ MHz}$	$U_R = 0 \text{ V}$	C_o	<2	pF

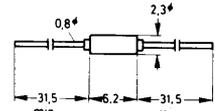
Durchlasskennlinie

$$I_F = f(U_F)$$





Ausführung Si-Lokal-Epitaxial-Z-Diode im Glasgehäuse DO 15. Katode durch Farbring gekennzeichnet. Kennzeichnung der Diode durch Aufdruck **ESM**, **BZX 85** Spannung und rotem Katodenring auf hellblauem Grund.



DO 15

Anwendung Si-Z-Diode mit besonders scharfem Abbruch der Sperrkennlinie, niedrigen Sperrströmen, geringem Rauschen und hoher Stabilität für Standard- und professionelle Anwendungen.

Grenzwerte bei $T_U = 25^\circ\text{C}$

Maximale Verlustleistung	P_{tot}^*	1,3	W
Lagertemperatur	T_S	-55... 150	$^\circ\text{C}$
Sperrschichttemperatur	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Wärmewiderstand			$^\circ\text{C}/\text{W}$
Sperrschicht/Luft	R_{thU}	≤ 97	

* Anschlußdrähte in 4 mm Abstand vom Gehäuse auf 25°C gehalten

vorläufige Daten

Grenz- und Kennwerte bei $T_U = 25^\circ\text{C}$

	Nennspannung $U_Z(\text{V})^*$	Durchbruchspannungsbereich $I_Z = I_{Z \text{ me\ss}}$ $U_Z(\text{V})$	dyn. Widerstand			
			$r_Z(\Omega)$	$I_{Z \text{ me\ss}}$ (mA)	$r_{ZK}(\Omega)$	bei $I_{ZK}(\text{mA})$
BZX 85 C 3 V 3	3,3	3,1... 3,5	10(<20)	80	<400	1
BZX 85 C 3 V 6	3,6	3,4... 3,8	8(<15)	60	<500	1
BZX 85 C 3 V 9	3,9	3,7... 4,1	8(<15)	60	<500	1
BZX 85 C 4 V 3	4,3	4,0... 4,6	7(<13)	50	<500	1
BZX 85 C 4 V 7	4,7	4,4... 5,0	5(<13)	45	<600	1
BZX 85 C 5 V 1	5,1	4,8... 5,4	5(<10)	45	<500	1
BZX 85 C 5 V 6	5,6	5,2... 6,0	4(<7)	45	<400	1
BZX 85 C 6 V 2	6,2	5,8... 6,6	2(<4)	35	<300	1
BZX 85 C 6 V 8	6,8	6,4... 7,2	1(<3,5)	35	<300	1
BZX 85 C 7 V 5	7,5	7,0... 7,9	1(<3)	35	<200	0,5
BZX 85 C 8 V 2	8,2	7,7... 8,7	2(<5)	25	<200	0,5
BZX 85 C 9 V 1	9,1	8,5... 9,6	2(<5)	25	<200	0,5
BZX 85 C 10	10	9,4... 10,6	3(<7)	25	<200	0,5
BZX 85 C 11	11	10,4... 11,6	3,5(<8)	20	<300	0,5
BZX 85 C 12	12	11,4... 12,7	4(<9)	20	<350	0,5
BZX 85 C 13	13	12,4... 14,1	5(<10)	20	<400	0,5
BZX 85 C 15	15	13,8... 15,6	6(<15)	15	<500	0,5
BZX 85 C 16	16	15,3... 17,1	6(<15)	15	<500	0,5
BZX 85 C 18	18	16,8... 19,1	8(<20)	15	<500	0,5
BZX 85 C 20	20	18,8... 21,2	10(<24)	10	<600	0,5
BZX 85 C 22	22	20,8... 23,2	12(<25)	10	<600	0,5
BZX 85 C 24	24	22,8... 25,6	12(<25)	10	<600	0,5
BZX 85 C 27	27	25,4... 28,6	15(<30)	10	<750	0,25
BZX 85 C 30	30	28,4... 31,6	15(<30)	10	<1000	0,25
BZX 85 C 33	33	31,3... 34,5	18(<35)	10	<1000	0,25

* Impulsweise gemessen: $t_p < 100 \text{ ms}$

Grenz- und Kennwerte bei $T_U = 25^\circ\text{C}$

	Sperrstrom		Z-Strom	Z-Stromstoß $t < 10 \text{ ms}$	TK der U_Z bei I_Z	Durchlaß- spannung $I_F = 200 \text{ mA}$
	bei $I_R (\mu\text{A})$	$U_R (\text{V})$	$I_Z \text{ max}$	$I_{ZS} (\text{mA})$	TK ($10^{-4}/^\circ\text{C}$)	$U_F (\text{V})$
BZX 85 C 3 V 3	40	1			-6,5	<1
BZX 85 C 3 V 6	20	1			-6,5	<1
BZX 85 C 3 V 9	10	1			-4,5	<1
BZX 85 C 4 V 3	3	1			-4,5	<1
BZX 85 C 4 V 7	3	1,5	<210	<1050	2	<1
BZX 85 C 5 V 1	1	2	<200	<980	2	<1
BZX 85 C 5 V 6	1	2	<180	<890	3	<1
BZX 85 C 6 V 2	1	3,8	<160	<800	4	<1
BZX 85 C 6 V 8	1	4	<150	<730	4,5	<1
BZX 85 C 7 V 5	1	4,5	<135	<660	5	<1
BZX 85 C 8 V 2	1	5	<120	<610	5,5	<1
BZX 85 C 9 V 1	1	6,5	<110	<550	6	<1
BZX 85 C 10	0,5	7	<100	<500	6,5	<1
BZX 85 C 11	0,5	7,7	<90	<450	7	<1
BZX 85 C 12	0,5	8,4	<85	<410	7	<1
BZX 85 C 13	0,5	9,1	<77	<380	7,5	<1
BZX 85 C 15	0,5	10,5	<67	<330	7,5	<1
BZX 85 C 16	0,5	11,2	<62	<310	8	<1
BZX 85 C 18	0,5	12,6	<55	<275	8	<1
BZX 85 C 20	0,5	14	<50	<250	8	<1
BZX 85 C 22	0,5	15,4	<45	<225	8,5	<1
BZX 85 C 24	0,5	16,8	<42	<205	8,5	<1
BZX 85 C 27	0,5	18,9	<37	<185	8,5	<1
BZX 85 C 30	0,5	21	<33	<165	8,5	<1
BZX 85 C 33	0,5	23,1	<30	<150	8,5	<1

vorläufige Daten

Zulässige
Gesamtverlustleistung
 $P_{tot} = f(T_U)$

